

## Super Fast Recovery Diode, 200A

**Features**

- Dual Diode Construction
- Low Leakage Current
- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- Super Fast Switching



TWIN TOWER PACKAGE

**Maximum Ratings** ( $T_J = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)

| Parameter                                            | Symbol      | Conditions                   | MUR20005CT(R) | MUR20010CT(R) | MUR20020CT(R) | Units |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Repetitive peak reverse voltage                      | $V_{RRM}$   |                              | 50            | 100           | 200           | V     |
| RMS reverse voltage                                  | $V_{RMS}$   |                              | 35            | 70            | 140           | V     |
| DC blocking voltage                                  | $V_{DC}$    |                              | 50            | 100           | 200           | V     |
| Average forward current                              | $I_{F(AV)}$ | $T_C \leq 140^\circ\text{C}$ | 200           | 200           | 200           | A     |
| Non-repetitive forward surge current, half sine-wave | $I_{FSM}$   | $T_C = 25^\circ\text{C}$     | 800           | 800           | 800           | A     |

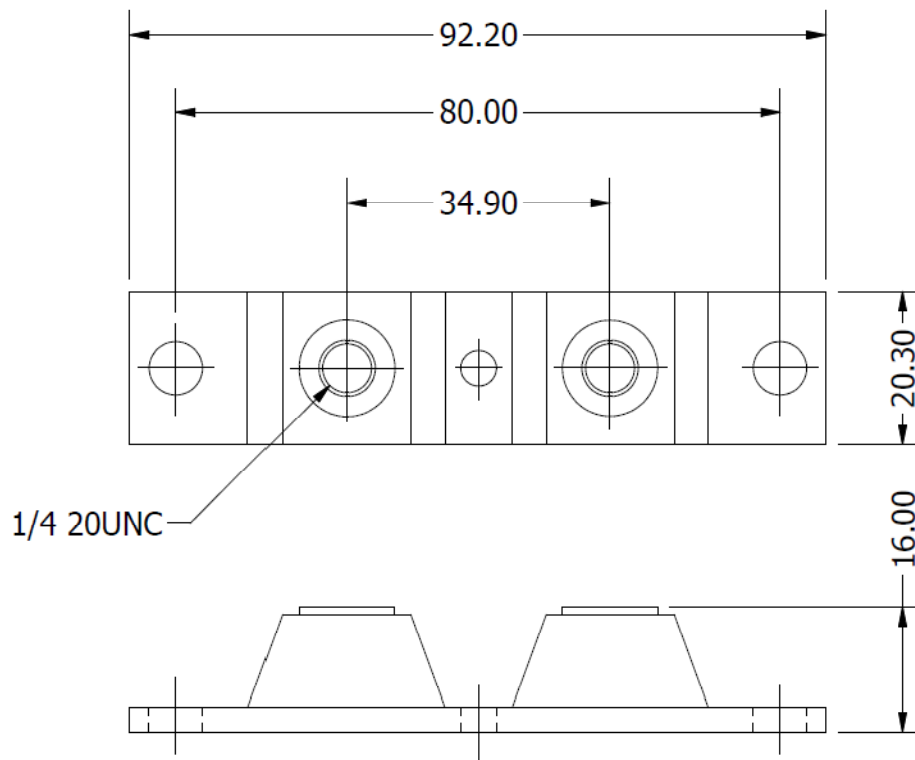
**Electrical Characteristics** ( $T_J = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)

| Parameter                     | Symbol   | Conditions                                                               | MUR20005CT(R) | MUR20010CT(R) | MUR20020CT(R) | Units         |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DC forward voltage            | $V_F$    | $I_F = 50\text{ A}$<br>$T_J = 25^\circ\text{C}$                          | 1.3           | 1.3           | 1.3           | V             |
| DC reverse current            | $I_R$    | $V_R = 50\text{ V}$<br>$T_J = 25^\circ\text{C}$                          | 25            | 25            | 25            | $\mu\text{A}$ |
|                               |          | $V_R = 50\text{ V}$<br>$T_J = 125^\circ\text{C}$                         | 1             | 1             | 1             | mA            |
| Maximum Reverse Recovery Time | $t_{rr}$ | $I_F = 0.5\text{ A}$<br>$I_R = 1.0\text{ A}$<br>$I_{RR} = 0.25\text{ A}$ | 75            | 75            | 75            | nS            |

**Thermal Characteristics** ( $T_J = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)

| Parameter                            | Symbol         |  | MUR20005CT(R) | MUR20010CT(R) | MUR20020CT(R) | Units              |
|--------------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Thermal resistance junction to case  | $R_{thJ-C}$    |  | 1.0           | 1.0           | 1.0           | $^\circ\text{C/W}$ |
| Operating, storage temperature range | $T_J, T_{stg}$ |  | - 40 to +175  | - 40 to +175  | - 40 to +175  | $^\circ\text{C}$   |

### Package Outline



ALL DIMENSIONS IN MM

### Ordering Table

| MUR | 200 | 05 | CT |
|-----|-----|----|----|
| 1   | 2   | 3  | 4  |

1 – Device Type

> MUR = Dual Diode Recovery Module

2 – Current Rating =  $I_{F(AV)}$

3 – Voltage = code x 10 =  $V_{RRM}$

4 – Polarity

> CT = Normal (Cathode to Base)

> CTR = Reverse (Anode to Base)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9